

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Институт естественных и точных наук
Кафедра «Физика наноразмерных систем»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
«Физика наноразмерных систем»
_____ / Воронцов А.Г. /
« ____ » _____ 2025 г.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Направление подготовки: 11.04.04 Электроника и наноэлектроника
Магистерские программы: Квантовая инженерия: материалы, электроника,
коммуникации и вычисления
Форма обучения: очная

2025 г.

Вводная часть

Порядок и форма организации вступительных испытаний

Вступительное испытание при приеме на обучение по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» (уровень магистратуры) проводится в очной форме в виде электронного тестирования по физике и электронике. Тест состоит из 25 вопросов на знание определений и законов физики, знание схемотехнических обозначений, принципов работы основных элементов электроники.

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний

Результаты прохождения вступительного испытания оцениваются по 100-бальной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, устанавливается равным 30 баллам.

**Перечень вопросов для второй части испытания по направлению подготовки
11.04.04 «Электроника и нанoeлектроника» (уровень магистратуры)**

1. Классификация материалов электронной техники по электропроводности. Признаки классификации, примеры.
2. Качественная зависимость электросопротивления проводника и полупроводника от температуры.
3. Что такое полуметаллы? Их характеристики, примеры.
4. Качественная зависимость электропроводности примесного полупроводника от температуры.
5. Материалы высокой проводимости. Оценить концентрацию электронов проводимости в металле.
6. Суть теории электропроводности по Друде-Лоренцу.
7. Сущность квантового подхода к теории электропроводности.
8. Уравнение Шредингера, волновая функция?
9. Биполярный транзистор. Схемы включения и режимы работы.
10. Входные и выходные характеристики БТ в схеме с общим эмиттером. Пояснить ход и области режимов.
11. Классификация полевых транзисторов и их принципы работы.
12. КМОП-структура и ее применение в схемотехнике цифровых устройств.
13. Принципы организации статической памяти на КМОП-транзисторах. Пример ячейки памяти.
14. Ячейка динамической памяти на полевом транзисторе: схема и принцип работы.
15. Базовые логические элементы на основе ТТЛШ.
16. Базовые логические элементы на основе КМОП.
17. Структура микропроцессора и принцип работы.
18. Структура микроконтроллера и принципы управления исполнительными устройствами.
19. Функциональная схема и назначение шифратора и дешифратора.
20. Функциональная схема и назначение мультиплексора.
21. Функциональная схема и принцип работы триггера.
22. Суть планарной технологии в микроэлектронике.
23. Сущность интегральной технологии в производстве микросхем.
24. Признаки нанoeлектроники. Минимальный технологический размер.

Литература

1. Гуртов В.А. «Твердотельная электроника» (любой год издания)
2. Холодков И.В. «Твердотельная электроника» (любой год издания)
3. Шишкин Г.Г. «Нанoeлектроника: элементы, приборы, устройства» (любой год издания)
4. Шука А.А. «Электроника»(любой год издания)
5. Игнатов А.Н. и др. «Классическая электроника и нанoeлектроника.» (любой год издания)